Acta Phys. -Chim. Sin., 2006, 22(1):110~113

[Note]

www.chem.pku.edu.cn/whxb

硼酸镁纳米带的制备、结构和生长机理

张 弜* 赵彦明

(华南理工大学物理科学与技术学院,广州 510640)

摘要 以晶态 B 和纳米 MgO 粉末为原料,在 1100 ℃含水的气氛下反应制备了新型准一维纳米材料硼酸镁纳米带.采用多种表征方法,如 X 射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM),能量色散谱仪(EDS)和傅立叶红外(FT-IR)等,研究了产物的形貌和结构.结果表明,除了部分附着的 $Mg_2B_2O_5$ 颗粒外,产物主要为单晶的 $Mg_3B_2O_6$ 纳米带. 其宽度在 $100\sim200$ nm,长度达到几十微米,生长方向大致为[010]方向.简要讨论了硼酸镁纳米带的生长机理和反应温度对产物的影响.

关键词: 硼酸镁, 单晶, 纳米带, 生长机理

中图分类号: O642, O613.8

Synthesis, Structure and Growth Mechanism of Magnesium Borate Nanobelts

ZHANG, Jiang * ZHAO, Yan-Ming

(School of Physics Science and Technology, South China University of Technology, Guangzhou 510640, P. R. China)

Abstract Magnesium borate nanobelts, a new kind of quasi one-dimensional nanomaterials, has been synthesized by heating mixed powders of crystalline boron and MgO nanoparticles in the presence of H_2O at $1100\,^{\circ}C$. The produced white sample was characterized by different techniques, such as the X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The results show that the products are single-crystalline $Mg_3B_2O_6$ nanobelts except some attached $Mg_2B_2O_5$ particles. The widths of the nanobelts are in the range of $100\sim200\,$ nm and the lengths are up to several ten micrometers. The growth direction of the nanobelts nears to crystalline $Mg_3B_2O_6$ [010] direction. Finally, the growth mechanism for these novel $Mg_3B_2O_6$ nanobelts and the effect of reactive temperature on the products have been primarily presented.

Keywords: Magnesium borate, Single-crystalline, Nanobelts, Growth mechanism

碳纳米管¹¹的发现引起了科学家对一维纳米材料极大的关注. 随后的研究发现,除了管状结构外,一维纳米材料还有纳米线(丝)、纳米棒等,它们的共同特征是截面为圆形或椭圆形. 2001 年, Wang 等¹²首次报道了准一维的氧化物半导体纳米带,其结构特点是横截面为一窄矩型,带宽为 30~300 nm,厚度为 5~10 nm,而长度可达几毫米. 与碳纳米管以及硅

和复合半导体线状结构相比,这是迄今为止发现的 具有可控结构且无缺陷的宽带隙半导体准一维带状 结构,而且具有比碳纳米管更独特的结构和优越的 物理性能.此后又陆续合成了其他一系列氧化物半 导体纳米带^[3-5].同时也出现了一些非氧化物的纳米 带,如高温反应制备的 GaN 纳米带^[6],触媒还原制备 的碳纳米带^[7],水热法制备的 Te 纳米带^[8],激光烧蚀

Received: May 24, 2005; Revised: August 20, 2005. *Correspondent, E-mail: jonney@scut. edu. cn; Tel: 020-87114127.

法制备的硼纳米带^[9]等. 对非氧化物纳米带的研究 扩大了纳米带这类准一维纳米材料的研究范围, 对 于发现新的纳米结构和发展纳米技术新的应用具有 极大的意义.

硼酸镁最早是以天然晶须的形式在韩国南部被发现¹¹⁰,这种天然矿物称为遂安石(suanite).最初人工合成的硼酸镁晶体是片状和棱柱状¹¹¹,不是晶须状形式.直到 1984 年在日本四国工业技术研究所成功地人工合成了硼酸镁晶须¹¹².高温反应制备的生成物主要是 Mg₂B₂O₅,但产品是单晶和三晶的混合物,或含有 MgB₄O₇,或含有 Mg₃B₂O₆. 其特点是轻质、高韧、耐磨、耐腐蚀,而且同其他晶须材料相比,具有价格低廉的优势,是当今复合材料领域最有希望广泛应用的晶须材料之一. 此外硼酸镁还是一种热释光荧光体¹¹³. 硼酸镁的纳米颗粒可以作为减摩材料添加到润滑油中¹¹⁴,同时硼酸镁还可以作为清净剂在加氢油中使用¹¹⁵.最近,Ma等¹¹⁶在 Si 基片上生长了单晶的硼酸镁(Mg₃B₂O₆)纳米管.本文则报道了准一维结构的单晶 Mg₃B₂O₆ 纳米带.

1 实 验

1.1 硼酸镁纳米带的制备

首先将晶态 B 和纳米 MgO 粉末按 1:1 的摩尔比球磨混合. 卧式高温炉中间插有一根直径 40 cm 的石英管, 称取 0.5 g 混合粉末放入石英舟中, 置于石英管的中心热区. 通入流量为 300~500 mL·min¹的 Ar 气, Ar 气流经装有去离子水的洗气瓶, 带入一定的水汽. 同时用电加热器加热洗气瓶, 温度控制在80 ℃左右. 从室温快速(约 1 h)升温至 1100 ℃, 反应时间为 1.5 h. 反应结束后在灰色粉末表面得到了白色产物. 为了研究温度对反应产物的影响, 在其他条件不变的情况下, 分别在温度为 900、1000 和 1200

Ace V Spec Mayn Dail WD Exp 5 μm

℃下进行实验.

1.2 结构表征

产物的相结构用 X 射线衍射仪(Riguku, DMax/2500)分析. 采用扫描电镜(SEM, Sirion-FSEM)观察产物的形貌, 扫描电镜配有能量色散谱仪(EDS). 同时用镊子取少量产物, 在无水乙醇中超声 10 min, 将一滴悬浊液滴到覆有碳膜的透射电镜用铜网上, 在透射电镜(TEM, JEM-200CX)下观察产物的形貌和微观结构. 高分辨电镜(HRTEM)观察在Philips-CM200 电镜上进行. 产物的红外光谱用 Nicolet 5DX-FT 傅立叶红外谱仪采集.

2 结果与讨论

图 1a 是白色产物的 SEM 形貌. 从图中可以明显看到大量带状纳米结构, 部分纳米带呈弯曲形状, 这说明合成的纳米带具有良好的塑性, 可以承受较大的变形. 单根纳米带宽度均匀, 边缘规则、清晰. 纳米带的宽度在 100~200 nm 之间, 长度可达几十微米. 单根纳米带的 EDS 测试(图 1b)表明纳米带的化学组成大约是 Mg:B:O=1.0:0.6:2.0, 与 Mg₈B₂O₆ 的化学组成很接近. 此外还可以看到有部分颗粒(箭头所示)黏附在纳米带上, 我们认为这是产物附带的灰色粉末, 下面的 XRD 分析也证明了这一点.

图 2 是白色产物及灰色粉末的 XRD 图谱. 图 2 中谱线(a)的衍射峰可以标定为正交晶系的 $Mg_3B_2O_6$ 相, 点阵参数为a=0.5401 nm, b=0.8423 nm, c=0.4507 nm (JCPDS 38-1475), 此外还有部分三斜晶系的 $Mg_2B_2O_5$ 相(JCPDS 83-0625). 灰色粉末的 XRD 图谱 (谱线 b)则表明粉末中只有 $Mg_2B_2O_5$ 相. 所以白色产物应是 $Mg_3B_2O_6$, 这与 EDS 成分测试的结果相对应. TEM 的观察与分析也证实, 得到的带状纳米结构是 $Mg_3B_2O_6$ 纳米带.

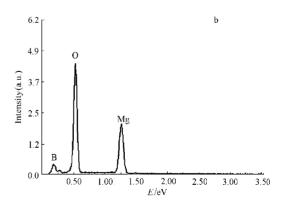


图 1 白色产物的 SEM 照片(a)和单根纳米带的 EDS 图谱(b)

Fig.1 SEM image of white products (a) and EDS pattern of an individual nanobelt (b)

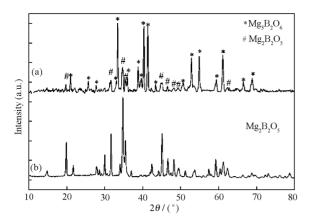


图 2 白色产物(a)和灰色粉末(b)的 XRD 图谱 Fig.2 XRD spectra of white products(a) and grey powders(b)

图 3 为不同形貌产物的 TEM 图像和单根纳米 带的 HRTEM 图像. 图 3(a)中主要是平直的纳米带, 其边缘平滑, 宽度在 100~200 nm, 长度达到几十微 米. 在透射电镜电子束辐照下纳米带的衬度较低, 估 计其厚度在几十纳米. 图 3(b)给出了弯曲纳米带的 形貌, 从纳米带弯折处估测其厚度为 50~100 nm, 宽 厚比为 5~10. 在图 3(b)中还可以发现有波纹状的衬 度出现,这主要是由纳米带弯曲引发的应变所导致 的弯曲消光条纹. 图 3(c)是一些特殊形貌的纳米结 构, 如边缘呈现之字形的纳米带(图中箭头所示), 带 有分叉的纳米结构. 这种结构在超声制备电镜样品 的过程中没有脱落,说明这种结构有很好的稳定性, 图 3(d)给出了单根 Mg₃B₂O₆ 纳米带的典型 HRTEM 图像,图中右侧是相应的选区衍射(SAED)([10]]晶带 轴) 花样, 左下角插图是放大了的高分辨像. 图中条 纹的间距约为 0.27 nm, 与 Mg₃B₂O₆ (121) 面间距相 当. 通过对图 3(d)中选区衍射花样的分析, 可知纳米 带为缺陷较少的单晶结构, 其生长的方向近似为 [010]方向.

图 4 是白色产物的 FT-IR 光谱. 在 1387、1024、 717 和 501 cm⁻¹ 处的吸收峰是 Mg₂B₂O₅ 的红外吸收 特征峰, 而 1290、1201、679 和 609 cm⁻¹ 处的吸收峰 是Mg₃B₂O₆的红外吸收特征峰^[17],其中Mg₂B₂O₅的吸收 峰来自白色产物上附着的颗粒. 两者强度的差别主 要是由Mg₃B₂O₆和Mg₂B₂O₅的红外活性不同引起的.

对于氧化物纳米带的生长机理,目前还不是很 明确. Wang等同对高温蒸发法制备的ZnO纳米带提 出了一个可能的机理,认为在高温下原料被气化后 以分子形式存在,然后在低温区沉积到基底上形核. 随着反应的继续,被气化的其他分子继续在已获得 的晶核上沉积,并首先开始形成具有最低能量的晶 面. 更多的分子附着在生长前沿的粗糙表面, 导致晶 面面积的继续扩张. 头部的粗糙表面使得新到的原 子迅速堆积,快速形成纳米带,经过一定时间后,生 长成为长纳米带. 电镜观察显示出纳米带的端部为

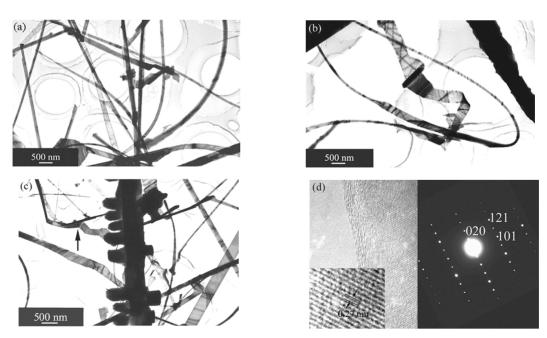


图 3 纳米带的 TEM 图像和 HRTEM 图像 Fig.3 TEM morphologies of the nanobelts and HRTEM image of the nanobelt

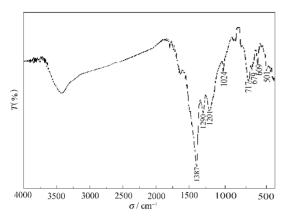


图 4 白色产物的 FT-IR 光谱

Fig.4 FT-IR spectrum of the white products

弧形,说明生长前沿为富集台阶、突起等的原子级粗糙面.新到的分子可能落在生长前沿,也可能落在侧面,但是由于侧面原子级光滑和生长温度下分子的活性很高,阻止分子在侧面的停留.纳米带的截面尺寸由生长温度和晶体生长动力学的过饱和度决定.

我们制备 Mg₃B₂O₆ 纳米带的过程与上述制备 ZnO 的过程不同, 纳米带不是在低温区得到的, 而是从没有完全反应的原料表面收集的, 从而没有原料气化后在基底重新形核生长的过程. 参考Ma等^[16]提出的 Mg₃B₂O₆ 纳米管生长的机理, 我们提出以下的生长机理. 首先, 反应过程中 B 颗粒的表面被 MgO 或 Ar 气带进的水汽氧化成 B₂O₃. 然后 B 将与熔融的 B₂O₃ 反应生成玻璃状聚合体(BO)_m, 同时 Mg或 MgO 蒸气会沉积在聚合体的表面, 并溶到玻璃体中, 当溶解达到过饱和时, 就会析出 Mg₃B₂O₆. 析出的 Mg₃B₂O₆ 首先开始形成具有最低能量的晶面,随着硼酸镁的进一步析出, 沿特定的方向(在本文中近似是[010])生长成纳米带. 与制备 Mg₃B₂O₆ 纳米管的过程不同, 本实验中没有纳米管形核所必需的纳米孔洞^[16], 因而产物不是纳米管而是纳米带.

Mg 的熔点(650 ℃)较低, 而玻璃状的氧化硼的蒸气压较低, 所以气相中主要是 Mg, 同时在有水汽的条件下, Mg 蒸气还可以被氧化, 所以气相中还有MgO. 根据MgO-B₂O₃的相图^{II3}, MgO过量时更容易生成 Mg₃B₂O₆(3MgO·B₂O₃), 这就可以解释为什么生成的是 Mg₃B₂O₆(3MgO·B₂O₃)纳米带, 而不是 Mg₂B₂O₅ (2MgO·B₂O₃)或 MgB₄O₇ (MgO·2B₂O₃)相.

在研究温度对硼酸镁纳米带制备的影响时发现, 当反应温度为900℃, 没有纳米带生成, 在1000

℃反应生成的纳米带的产量很少,而当反应温度为 1200 ℃得到的产物很粗大,形成了硼酸镁晶须. 这 是由于生长温度过高,反应物原子的活性也大大增强,生长速度加快使得产物更加粗大. 因此,制备硼酸镁纳米带合适的温度应该在 1100 ℃左右.

3 结 论

在含有水汽的 Ar 气氛中, 加热 B 和纳米 MgO 的混合粉末到 1100 $^{\circ}$ C,得到了单晶的硼酸镁纳米 带. XRD 和 EDS 测试表明纳米带为 Mg₃B₂O₆ 结构. TEM 观察和分析表明,纳米带是结晶完整 Mg₃B₂O₆ 单晶结构,生长方向接近[010]方向. Mg₃B₂O₆ 纳米带的生长遵循一种溶解析出的过程. 进一步的实验表明,硼酸镁纳米带生长的合适温度约为 1100 $^{\circ}$ C.

References

- 1 Iijima, S. *Nature*, **1991**, **354**: 56
- 2 Pan, Z. W.; Dai, Z. R.; Wang, Z. L. Science, 2001, 291: 1947
- 3 Zhang, J.; Zhang, L. Solid State Communication, 2002, 122: 493
- 4 Jian, J. K.; Chen, X. L.; Wang, W. J.; Dai, L.; Xu, Y. P. Appl. Phys. A, 2003, 76: 291
- 5 Dai, Z. R.; Pan, Z. W.; Wang, Z. L. Advanced Functional Materials, 2003, 13: 9
- 6 Bae, S. Y.; Seo, H. W.; Park, J. H.; Yang, H.; Park, J. C.; Lee, S. *Appl. Phys. Lett.*, **2002**, **81**: 126
- 7 Liu, J. W.; Shao, M. W.; Tang, Q.; Zhang, S. Y.; Qian, Y. T. J. Phys. Chem. B, 2003, 107: 6329
- 8 Mo, M. S.; Zeng, J. H.; Liu, J. W.; Yu, W. C.; Zhang, S. Y.; Qian, Y. T. Adv. Mater., 2002, 14: 1656
- 9 Wang, Z.; Shimizu, Y.; Sasaki, T.; Kawaguchi, K.; Kimura, K.; Koshizaki, N. Chem. Phys. Lett., 2003, 368: 663
- 10 Watanabe, T. Mineral J., 1952, 1: 54
- 11 Nefedov, E. I. Materialy Vses., 1961, 2: 243
- 12 Kitamura, T.; Kato, S.; Wada, H. Whisker of magnesium borate and its preparation. J. P. Patent, 1985. 60-204697
- 13 Shahare, D. I.; Dhoble, S. J.; Moharil, S. V. J. Mater. Sci. Lett., 1993, 12: 1873
- 14 Hu, Z. S.; Lai, R.; Lou, F.; Wang, L. G.; Chen, Z. L.; Chen, G. X.; Dong, J. X. Wear, 2002, 252: 370
- 15 Xu, X. H.; Liu, Q. S. Lubrication Engineering, **2000**, **5**: 45 [徐小红, 刘全山. 润滑与密封(Runhua Yu Mifeng), **2000**, **5**: 45]
- 16 Ma, R. Z.; Bando, Y.; Golberg, D.; Sato, T. Angew. Chem., 2003, 42, 1026
- 17 Farmer, V. C. Infrared spectroscopy of mineral. Trans. Ying, Y. P.; Wang, S. S.; Li, C. G. Beijing: Science Press, 1982: 126 [矿物 的红外光谱. 应育浦, 汪寿松, 李春庚译. 北京: 科学出版社, 1982: 126]
- 18 Mutluer, T.; Timucin, M. J. Am. Ceram. Soc., 1975, 58: 196